



NAND/DRAM 价格小幅波动，美光 HBM 产能维持高增速 ——存储芯片周度跟踪（2024.05.20-2024.05.24）

核心观点

NAND: NAND 颗粒市场价格小幅波动，SLC NAND 价格或将温和上涨。根据 DRAMexchange，上周（0520-0524）NAND 颗粒 22 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-3.67%至 1.33%，平均涨跌幅为-0.23%。其中 7 个料号价格持平，6 个料号价格上涨，9 个料号价格下跌。根据证券时报网报道，展望后市兆易创新公司高管预计，鉴于 SLC NAND 需求回暖和价格上涨比利基 DRAM 大约晚一个季度，判断 SLC NAND 未来价格将温和上涨。

DRAM: 颗粒价格小幅波动，三星电子 3D DRAM 堆叠至 16 层。根据 DRAMexchange，上周（0520-0524）DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至 0.25%，平均涨跌幅为-0.63%。上周 3 个料号呈上涨趋势，15 个料号呈下降趋势，0 个料号价格持平。根据 CFM 闪存市场报道，三星电子成功将下一代存储半导体 3D DRAM 堆叠到 16 层。3D DRAM 是一种称为“垂直堆叠单元阵列晶体管(VS-CAT)”的下一代存储器，其概念是像堆叠纸张一样垂直堆叠 DRAM 单元。三星电子通过 VS-CAT 和垂直通道晶体管(VCT)等，旨在在下一代 DRAM 市场中拉开技术差距。

HBM: 美光 2025 年 HBM 供应谈判已基本完成，未来产能 CAGR 或达 50%。根据 CFM 闪存市场报道，美光 HBM 业务规模在 2025 会计年度将增长至数十亿美元。美光 2025 年 HBM 供应谈判基本上已经完成，已与下游客户基本敲定了 2025 年 HBM 订单的规模和价格。美光预测，在未来数年间其 HBM 的位元产能的复合年成长率将达到 50%。

市场端: 渠道和行业部分 SSD 价格小幅下调。上周（0520-0524）eMMC 价格与 UFS 价格持平。根据 DRAMeXchange 报道，市场整体需求氛围表现不佳，现货市场卖压持续扩大，终端需求亦未见好转，原厂端虽积极拉抬官价，但仅在 SSD 部分造成微幅波动，零星成交，无法拉抬并带动整体买气，wafer 及 eMMC 报价方面持续下探。

投资建议

我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。

HBM: 受益于算力芯片提振 HBM 需求，相关产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

存储芯片: 受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

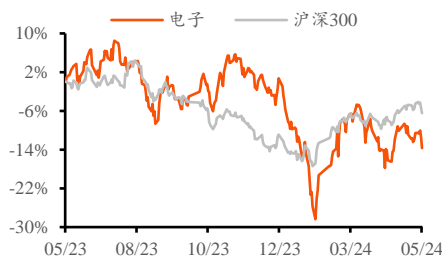
风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子
日期： 2024年05月27日
分析师： 陈宇哲
E-mail: chenyzhe@yongxingsc.com
SAC 编号: S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

相关报告:

- 《NAND/DRAM 价格小幅波动，HBM 两巨头敲定合作》
——2024 年 05 月 22 日
- 《微软或开放自研芯片，SK 海力士与台积电合作 HBM》
——2024 年 05 月 20 日
- 《联发科发布 AI 移动芯片，Q2 服务器存储或维持涨价》
——2024 年 05 月 13 日

正文目录

1. 存储芯片周度价格跟踪	3
2. 行业新闻	4
3. 公司动态	6
4. 公司公告	7
5. 风险提示	8

图目录

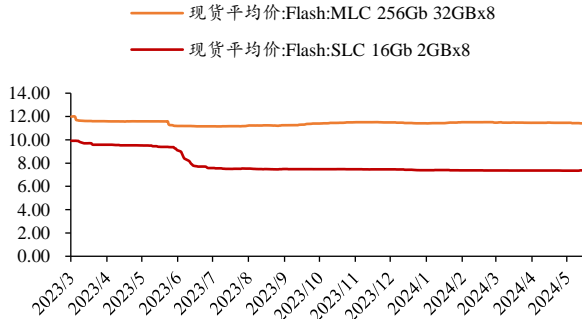
图 1: NAND 中大容量现货价格 (美元)	3
图 2: NAND 中小容量现货价格 (美元)	3
图 3: NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)	3
图 4: NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)	3
图 5: DRAM 中大容量现货价格 (美元)	3
图 6: DRAM 中小容量现货价格 (美元)	3

表目录

表 1: 存储行业本周重点公告 (5.20-5.24)	7
-----------------------------------	---

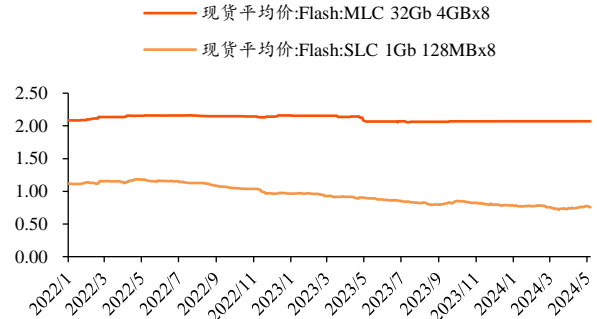
1. 存储芯片周度价格跟踪

图1:NAND 中大容量现货价格 (美元)



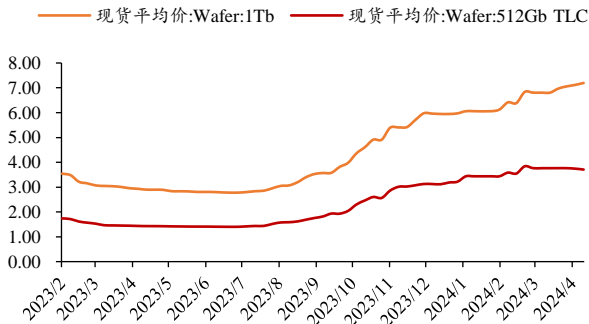
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图2:NAND 中小容量现货价格 (美元)



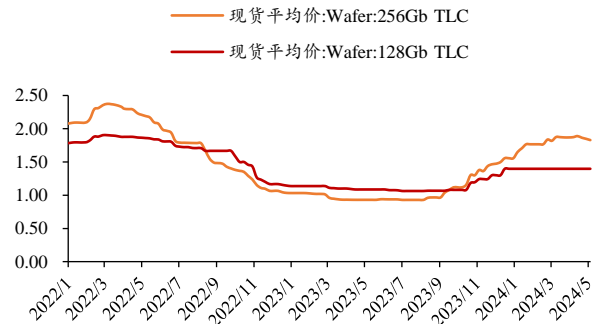
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图3:NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)



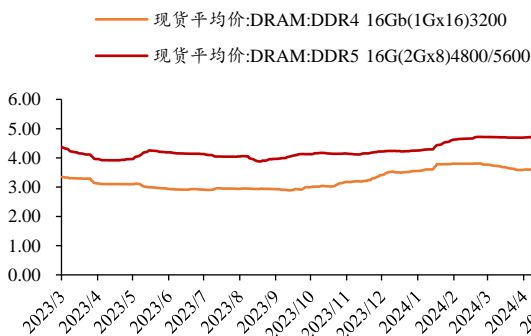
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图4:NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)



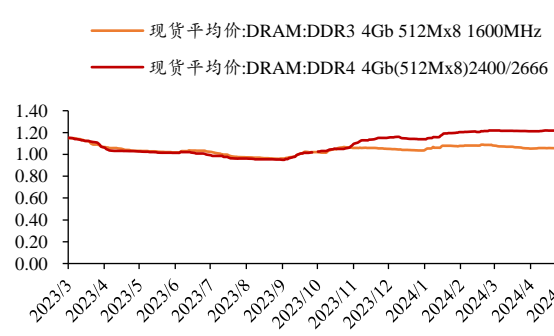
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图5:DRAM 中大容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图6:DRAM 中小容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

2. 行业新闻

本周现货 SSD 和内存价格再度下调，消费类存储行情疲软

5月21日消息，根据CFM闪存市场报道，淡季消费类存储市场需求持续低迷，现货SSD和内存价格继上周普跌后，本周再度延续全面下跌的态势。二季度过半，消费类存储需求持续遇冷，现货SSD和内存需求端砍单及议价氛围浓郁，实际成交跟进艰难，个别产品杀价激烈，令存储现货市场降价抛售现象加剧。虽然各大原厂力挺存储价格，积极满足AI服务器备货需求，部分存储供应仍存在结构性缺口，但消费端存储需求短期却不容乐观，下游普遍面临流速放缓库存较高的考验。预计二季度后半程，消费类市场整体处于阶段性去库存的状态，存储现货市场卖压依然较重令行情波动加剧，部分现货资源及成品端价格将持续承压。消费端存储需求持续遇冷，存储渠道及行业市场以加快周转为主，进一步加剧竞价出货的现象，需求端拉大议价空间，本周现货SSD和内存价格再度全面下调。本周现货Flash Wafer及DDR资源价格全面下调，1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC Flash Wafer分别下跌至7.10/7.60/4.10/1.95美元，DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT调整至3.05/2.75/1.35/1.19美元。

资料来源：(CFM闪存市场)

美光2025年HBM供应谈判已基本完成

5月24日消息，根据CFM闪存市场报道，美光首席运营官Manish Bhatia表示，美光HBM业务规模在2025会计年度将增长至数十亿美元。同时，美光2025年HBM供应谈判基本上已经完成，已与下游客户基本敲定了2025年HBM订单的规模 and 价格。美光预测，在未来数年间其HBM的位元产能的复合年成长率将达到50%。为了应对HBM的强劲市场需求，美光上调了2024财年的资本支出金额，从75亿美元提升到80亿美元。在HBM技术发展方面，美光于本季度早些时间已开始提供12层堆叠的HBM3E样品。12层堆叠的HBM产品是容量提升50%的新品，预计将成为美光2025年业绩的重要来源；非HBM领域，美光认为AI PC的推出，将推动标准内存的需求成长达40~80%。美光高层预测，HBM业务近期的年复合增长率有望高达50%，从8层堆叠升级到12层堆叠的HBM，有望推升2025年度营收。

资料来源：(CFM闪存市场)

三星电子在3D DRAM技术上取得突破

5月20日消息，根据CFM闪存市场报道，三星电子成功将下一代存储半导体3D DRAM堆叠到16层。3D DRAM是一种称为“垂直堆叠单元阵

列晶体管(VS-CAT)”的下一代存储器，其概念是像堆叠纸张一样垂直堆叠 DRAM 单元。三星电子通过 VS-CAT 和垂直通道晶体管(VCT)等，旨在在下一代 DRAM 市场中拉开技术差距。三星电子除了 VS-CAT 之外，还在研究将晶体管结构垂直堆叠的 VCT 形式的 3D DRAM。行业将 VCT 称为 4F 平方。4F 平方是三星电子最近正在研究的单元阵列结构。据称，与 6F 平方相比，芯片尺寸可以减少约 30%。行业预计 VCT 结构将用于 10 纳米以下的 DRAM，并被评为解决微细化极限的关键之一。三星电子计划在 2025 年推出的样品也是 VCT 形式的 3D DRAM。

资料来源：(CFM 闪存市场)

NAND Wafer 及 eMMC 报价持续下探

5月25日消息，根据 DRAMeXchange 报道，市场整体需求氛围表现不佳，现货市场卖压持续扩大，终端需求亦未见好转，原厂端虽积极拉抬官价，但仅在 SSD 部分造成微幅波动，零星成交，无法拉抬并带动整体买气，wafer 及 eMMC 报价方面持续下探，导致其余相应产品询单依旧保守被动，低价部位无实质有力买单承接，整体交易情况不甚理想。在 Samsung 部分，SLC 报价大致持平，但在其它品牌到货卖压影响下，保有些许议价空间，固定询单因推迟备货时程，动作较为被动保守。SK Hynix 部分，SLC 整体买气仍是安静，供应端报价亦保守，仅随大盘微幅修正，但仍保留较多议价空间。Micron 部分，SLC 相对低价部位有些许询单，但仅止于探价阶段，订单大多推迟并持续询求低点，双方未见明显交集。Kioxia 部分，SLC 低容量有些许到货，加上工厂端调节库存，盘势明显走跌，低价部位无力承接，交易情况不佳。

资料来源：(DRAMeXchange)

兆易创新：SLC NAND 未来价格或将温和上涨

5月9日消息，根据证券时报网报道，展望后市兆易创新公司高管预计，随着供需关系变化，不同产品线都可能出现不同走势。存储产品中，2024 年第二季度及第三季度利基 DRAM 价格将持续温和上涨。鉴于 SLC NAND 需求回暖和价格上涨比利基 DRAM 大约晚一个季度，判断 SLC NAND 未来价格将温和上涨；NOR 产品价格后续走势仍需要持续观察。

资料来源：(证券时报网)

3. 公司动态

【澜起科技】PCIe Retimer 需求量也在快速增长

5月17日消息，澜起科技在投资者互动平台表示，DRAM内存模组（包括DRAM和MRDIMM）属于服务器主内存，与HBM的应用场景不同，分别有相对独立的市场空间，二者都将受益于AI产业的发展，并非竞争或替代关系。我们认为，基于高带宽、大容量的优势，MRDIMM有望成为未来AI和高性能计算主内存的优选方案，将大幅提升MRCD/MDB的潜在需求。而PCIe Retimer主要用于CPU与高速外设（如GPU、SSD、网卡等）之间的互连，随着以GPU为代表的AI芯片需求量不断增长，PCIe Retimer需求量也在快速增长。

资料来源：（投资者互动平台）

【江波龙】半导体存储行业目前处于上行复苏周期

5月17日消息，江波龙在投资者互动平台表示，受原厂减产，以及需求逐步复苏的影响拉动，目前半导体存储产业进入上行周期，存储晶圆以及存储器的价格均较年初有明显上升，半导体存储行业目前处于上行复苏周期。产业链上下游对于已出现的价格调整基本达成一致，您亦可以同步参阅相关媒体的公开报道。公司作为国内领先的综合型半导体品牌存储企业，生产经营态势与行业主流情形保持一致，同时公司的经营策略亦根据市场情况而实时调整。

资料来源：（投资者互动平台）

【聚辰股份】公司将进一步丰富在NOR Flash领域的产品布局

5月10日消息，聚辰股份在投资者互动平台表示，2024年公司将进一步丰富在NOR Flash领域的产品布局，并在成功完成64Mb-128Mb的NOR Flash产品流片的基础上，加强与供应商在工艺、技术等方面的合作与协同，缩短新产品量产的时间周期，同时积极推动16Mb及以上容量的NOR Flash产品通过AEC-Q100 Grade 1车规电子可靠性试验验证。此外，公司将从工艺制程和容量维度实现技术和产品迭代，在保障产品质量可靠和性能优异的前提下，达成业内相同容量产品芯片面积最小的目标，并依托技术水平与客户资源优势，不断提升在NOR Flash领域的市场份额和品牌影响力。

资料来源：（投资者互动平台）

4. 公司公告

表1: 存储行业本周重点公告 (5.20-5.24)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/05/24	华海诚科	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,696,453 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 24,208,935.90 元（含税）。
2024/05/21	北京君正	利润分配	以 2023 年 12 月 31 日总股本 481,569,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 96,313,982.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
2024/05/20	同有科技	股份回购注销	因 2023 年度公司业绩考核未达标、部分首次授予激励对象离职，公司将按照规定程序对前述涉及的 2,439,000 股办理回购注销手续。上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少 2,439,000 股，由 481,702,798 股减少至 479,263,798 股，注册资本将由 481,702,798 元减少至 479,263,798 元。

资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

5. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。